

**Projet : Excitation des ondes de plasma dans les transistors à haute mobilité.**

Transistors avec les capacitances intégrées et les bars de Halls couvertes par une grille (photo de chip ci-dessous).

Demande : Réalisation de connexions électriques entre le composant et son support (support DIL - 2me photo ci- dessous)

Dimensions de contacts  $\sim 70\text{ }\mu\text{m}$ .



